

# Физика и техника полупроводников, 2022, том 56, выпуск 10

<b>Неэлектронные свойства полупроводников (атомная структура, диффузия)</b> Дашдамирова Г.Е. <b>Электроннографическое исследование температурно-временных зависимостей кристаллизации нанотолщинных аморфных пленок <math>\text{CuIn}_5\text{Te}_8</math>, сублимированных в обычных условиях и в условиях воздействия внешнего электрического поля</b>	943
<b>Электронные свойства полупроводников</b> Расулов В.Р., Расулов Р.Я., Эшболтаев И.М., Кучкаров М.Х. <b>Поляризационно-спектральные зависимости трехфотонного межзонного поглощения света и линейно-циркулярного дихроизма в полупроводниках кубической симметрии</b>	948
<b>Спектроскопия, взаимодействие с излучениями</b> Байдакова Н.А., Яблонский А.Н., Гусев Н.С., Кудрявцев К.Е., Морозова Е.Е., Юрасов Д.В., Алешкин В.Я., Нежданов А.В., Новиков А.В. <b>Фотолюминесценция растянутых Ge микромоистиков при различных температурах: эксперимент и моделирование</b>	954
<b>Поверхность, границы раздела, тонкие пленки</b> Тимошнев С.Н., Бенеманская Г.В., Мизеров А.М., Соболев М.С., Эннс Я.Б. <b>Изменение электронной структуры поверхности GaN/Si(111) при адсорбции Li</b>	961
Кукушкин В.А. <b>Высокая подвижность дырок в дельта-легированных бором слоях алмаза: почему она до сих пор не достигнута и как ее можно достичь</b>	966
<b>Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления</b> Хомицкий Д.В., Запруднов Н.А. <b>Спин-зависимое туннелирование в двойной квантовой точке в режиме "медленной" эволюции</b>	973
Nammas F.S., Hasan Eyad Hasan <b>The Analytical Effects of a Hydrostatic Pressure on the Ground State Energy of GaAs Quantum Dot at Low-Temperature: Algebraic Method</b>	979
Петрушков М.О., Путято М.А., Васев А.В., Абрамкин Д.С., Емельянов Е.А., Лошкарев И.Д., Комков О.С., Фирсов Д.Д., Преображенский В.В. <b>Молекулярно-лучевая эпитаксия GaSb на вичинальных подложках Si(001): влияние условий зарождения слоев на их структурные и оптические свойства</b>	980
Надточий А.М., Мельниченко И.А., Иванов К.А., Минтаиров С.А., Калюжный Н.А., Максимов М.В., Крыжановская Н.В., Жуков А.Е. <b>Температурные зависимости излучательного и безызлучательного времени жизни носителей в квантовых яма-точках InGaAs</b>	993
<b>Физика полупроводниковых приборов</b> Афанасьев А.В., Забродский В.В., Ильин В.А., Лучинин В.В., Николаев А.В., Серков А.В., Трушлякова В.В., Чигирев Д.А. <b>Применение технологии реактивного ионно-плазменного травления для управления чувствительностью 4H-SiC-фотодиодов</b>	997
Бабичев А.В., Пирогов Е.В., Соболев М.С., Денисов Д.В., Фоминых Н.А., Баранов А.И., Гудовских А.С., Мельниченко И.А., Юнин П.А., Неведомский В.Н., Токарев М.В., Бер Б.Я., Гладышев А.Г., Карачинский Л.Я., Новиков И.И., Егоров А.Ю. <b>Исследование активных областей на основе многопериодных сверхрешеток GaAsN/InAs</b>	1002
<b>Изготовление, обработка, тестирование материалов и структур</b> Мохов Е.Н., Давыдов В.Ю., Смирнов А.Н., Нагалюк С.С. <b>Рост гексагонального нитрида бора (hBN) на подложках карбида кремния методом сублимации</b>	1011
<b>Персоналии</b> <b>Владимир Иванович Иванов-Омский</b>	1016
<b>Поправка</b>	1018

